

а 2019 0057

Изобретение относится к технологии изготовления полупроводниковых приборов, в частности к способам получения кристаллических слоев соединений III-N с электропроводностью р-типа на гетерогенных подложках.

Способ получения слоев р-GaN включает осаждение на гетерогенной подложке слоев ZnO из раствора ацетата цинка в этаноле с последующей термической обработкой при 500°C, последующее осаждение осадка ZnO из раствора нитрата цинка и KOH в дистиллированной воде кипячением и термической обработкой также при 500°C, с последующим введением в реактор осаждения слоев GaN методом HVPE, где сначала осаждается слой GaN при температуре 500°C, а затем осаждается собственно слой GaN при температуре 800...1050°C.

П. формулы: 1